

	<p>SQ4431EY-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ4431EY-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 10.8A 8SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SQ4431EY-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQ4431EY-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 10.8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SQ4431EY-T1-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 10.8A (Tc) 6W (Tc) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.8A (Tc)

SQ4431EY-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ4431EY-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ4431EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ4431EY-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ4425EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 18A 8SOIC</p>	 <p>SQ4431EY-T1-GE3 V SQ4431EY-T1-GE3 V</p>	 <p>SQ4425EY-T1-GE3 VISHAY SQ4425EY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ4425EY VISHAY SQ4425EY VISHAY</p>
 <p>SQ4435EY-T1-GE3 V SQ4435EY-T1-GE3 V</p>	 <p>SQ4470EY VISHAY SQ4470EY VISHAY</p>	 <p>SQ4435EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 15A 8SOIC</p>	 <p>SQ4435EY VISHAY SQ4435EY VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ4431EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ4431EY-T1_GE3 Datenblatt	SQ4431EY-T1_GE3-Datenblätter	SQ4431EY-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ4431EY-T1_GE3 Electronic	SQ4431EY-T1_GE3-Komponenten	SQ4431EY-T1_GE3-Verteiler	SQ4431EY-T1_GE3-Bild	SQ4431EY-T1_GE3-Teil
SQ4431EY-T1_GE3 Preis	SQ4431EY-T1_GE3 Hersteller	SQ4431EY-T1_GE3 Bild	SQ4431EY-T1_GE3 Aktie	SQ4431EY-T1_GE3 Inventar
SQ4431EY-T1_GE3 Neu	SQ4431EY-T1_GE3 Original	SQ4431EY-T1_GE3 garantiert	SQ4431EY-T1_GE3 RFQ	SQ4431EY-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited